論文

Al-Mg-Si系合金の曲げ変形初期の亀裂発生および 伝播に及ぼすミクロボイドの影響*

山本 裕介**, 浅野 峰生**, 吉田 英雄***, 小林 正和****, 戸田 裕之*****

Effect of Micro-Voids on Crack Initiation and Propagation in Bending Deformation of Al-Mg-Si Alloy Sheets*

Yusuke Yamamoto**, Mineo Asano**, Hideo Yoshida***, Masakazu Kobayashi**** and Hiroyuki Toda*****

The crack initiation and the propagation during bending have been considered to be affected by second phase particles with micro-voids and a shear-band. However, the effect of second phase particle distribution on formation of micro-voids, and the effect of micro-voids on crack initiation and propagation during bending have not been fully investigated. In this study, the effect of second phase particle distribution on the formation of micro-voids, and the effect of the micro-voids on crack initiation and the propagation during bending were investigated by using the largest synchrotron radiation facility "SPring-8" and FE-SEM/EBSD. With increasing the bending ratio, micro-voids were increased around the coarse particles nearby the outer surface. In particular, coarse micro-voids were formed around the coarse particles with high aspect ratio on the shear-bands. At a large cracking part, the coarse micro-void was observed at the outmost layer section as a crack initiation site, and coarse micro-voids and a sheared fracture surface were observed at a crack propagation site. At a small cracking part with no propagation, cube orientation grains were located under the small crack. It was considered that these cube orientation grains inhibited the formation of the shear-bands, therefore propagation of cracks did not occur at the small cracking area.

Keywords: Al-Mg-Si alloy, bending, micro-void, second phase particle, crack propagation, X-ray tomography

1. 緒 言

近年、CO₂排出量削減の観点から自動車の軽量化を 目的として、自動車ボディパネル等へのアルミニウム 合金板の適用が拡大している。自動車ボディパネル用 アルミニウム合金板材として、主にAl-Mg系合金およ びAl-Mg-Si系合金が使用されており、プレス成形時に ストレッチャーストレインマークが発生しないこと、 塗装焼付硬化性を有することなどから,Al-Mg-Si系合 金のT4調質材が主流となっている。フードやドア等の アウターパネルは,縁でインナーパネルをかしめる曲 げ加工(ヘミング)を行うが,Al-Mg-Si系合金のT4調 質材は室温時効の進行に伴って曲げ加工性が低下し, 曲げ加工時に割れが発生し易くなる¹⁾。そのため,曲 げ加工性の改善が強く望まれており,曲げ割れ発生メ カニズムの解明に向けた研究がなされてきた^{2)~6}。浅

*	本稿の主要部分は,軽金属,63 (2013),452-457に掲載							
	The main part of this paper has been published in Journal of Japan Institute of Light Metals, 64 (2013), 452-457.							
** (株) UACJ 技術開発研究所 名古屋センター 第三部								
	No. 3 Development, Nagoya Center, Research & Development Division, UACJ Corporation							
***	(株)UACJ 技術開発研究所							
	Research & Development Division, UACJ Corporation							
****	豊橋技術科学大学機械工学系							
	Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology							
****	九州大学工学研究院機械工学部門							
	Department of Mechanical Engineering, Kyushu University							

野らは、Al-Mg-Si系合金板において、曲げ加工による せん断帯の形成と全第2相粒子数 (2 μm以上)が共に多 い場合、曲げ加工性が低下することを報告しており、 以下の曲げ割れメカニズムを提案している²⁾。

①曲げ加工度の増加に伴って、第2相粒子周りでの ミクロボイドの形成が進行

②曲げ加工度の増加に伴って、せん断帯の形成が進行③せん断帯とミクロボイドに沿って割れが伝播

曲げ加工中に形成されたミクロボイドの形成状態の 観察は、一般的に樹脂埋め、研磨された試料を用いた 光学顕微鏡観察もしくは走査型電子顕微鏡観察により 行う。しかし、前述の方法では数µm以下のミクロボ イドの形成状態を正確に捉えることが非常に難しいた め、ミクロボイドの形成状態に及ぼす第2相粒子分布 の影響や曲げ割れ初期の亀裂発生に及ぼすミクロボイ ドの影響は十分には明らかにされておらず、推測の域 を脱していない。近年、大型放射光施設を利用した 3D/4D観察技術の発展に伴い、1 µm 程度のミクロボイ ドの観察が実現可能となってきた^{7),8)}。そこで、本研 究では、SPring-8を利用したX線CT観察を行った後、 同一試料にてSEM観察を行い、ミクロボイドの形成状 態に及ぼす第2相粒子の影響を調査した。その結果を 基に、曲げ割れ初期の亀裂発生に及ぼすミクロボイド の影響について考察した。

2. 実験方法

Table 1に示す化学成分を有する Al-Mg-Si系合金鋳 塊を均質化処理,熱間圧延,冷間圧延,溶体化処理に より0.9 mmのT4板材とした。曲げ試験は,圧延方向 に対して0°方向の押曲げ法 (JIS Z2248)により,内側 曲げ半径0 mmの180°曲げ試験(密着曲げ試験)を行 った。曲げ試験片の外観および模式図をFig.1に示 す。Fig.1(b)に示すように曲げ試験片の先端から1辺 約2 mmの棒状試料を切り出し,大型放射光施設 SPring-8のBL20XUにおいて,ミクロボイドおよび Al-Fe-Si系粒子の観察を行った。Fig.2に示すようにサ ンプルをセッティングし,透過X線を可視光に変換し た後,レンズで拡大してから可視光の強度を検出した。 これにより,1 μm程度の微小なミクロボイドやAl-Fe-Si系粒子を観察することができる。CT断層像から特徴

 Table 1
 Chemical compositions of specimens.
 (mass%)

Si	Fe	Cu	Mu	Mg	Cr	Zr	Ti	Al
1.0	0.17	0.02	0.07	0.52	Tr.	0.19	0.02	Bal.



Fig. 1 Appearance and schematic diagrams of a bending test sample.

- (a) Appearance of the sample surface.
- (b) and (c) Schematic diagram for sample preparation.
 - (b) For tomography measurement.
 - (c) For SEM observation.



Fig. 2 Schematic diagram of a sample setting for the tomography measurement.

的な断面を選択し、該当断面が得られるよう、Fig.1(c) に示すようにクロスセクションポリッシャー (CP)を 用いてArイオンにより切断した。この切断面におい て、SEM観察およびEBSD解析を行った。

3. 試験結果および考察

3.1 ミクロボイドの形成

Fig. 3に曲げ試験片先端部の3次元再構成像および CT断層像を示す。板厚内部まで伝播した割れ (fracture),局所的なくびれ(localized necking)や微小 な割れ(crack),曲げ加工部外面に現れた変形帯が観察 された。A-A断面におけるCT断層像は,厚さ5µmを 重ね合わせた像であり,黒点がミクロボイドである。 ミクロボイドは,表層近傍で顕著に形成されており, Fig. 3 (b)中に矢印で示すように特に局所くびれ領域の 延長上で粗大なミクロボイドが形成されていた。詳細 は後述するが,局所くびれ領域の延長上ではせん断帯 が形成されており, せん断帯上でミクロボイドの形成 が顕著であった。

また、ミクロボイドの板厚方向の分布に着目すると、 ミクロボイドは表層近傍で多く、板厚1/4部で減少し た後,板厚中心部で再度増加した。Fig. 4に曲げ部の 全板厚における反射電子像を示す。EDS分析の結果, 黒点がミクロボイド, 白点が Al-Fe-Si 系粒子であった。 Fig. 3に示したCT断層像と同様に、ミクロボイドは表 層近傍で多く、板厚1/4部で減少した後、板厚中心部 で再度増加した。さらに板厚3/4部から内側表層部(内 側曲げ部) にかけて、ミクロボイドはほとんど観察され なかった。このようなミクロボイドの分布状態から, 板厚中心部で形成されたミクロボイドは、曲げ加工の 歪分布が主原因ではなく, 鋳造時に形成されたミクロ ボイドが圧延後も残存していたものと考えられる。し かし、板厚中心部のミクロボイドは曲げ割れの発生に は直接影響しないため,形成原因の詳細については今 後の研究課題とした。

Fig. 4中のX領域, Y領域においてAl-Fe-Si系粒子と ミクロボイドの粒度分布を画像解析により計測した。 その結果をFig. 5に示す。Al-Fe-Si系粒子について, X 領域よりもY領域の方が2 µm以下の粒子数が多かっ た。一方, ミクロボイドについて, X領域よりもY領







Fig. 4 SEM image of the bending test sample through the gauge.



Fig. 5 Relation with histogram of Al-Fe-Si particles and histogram of micro-voids.(a) X area in Fig. 4. (b) Y area in Fig. 4.

域の方が3 µm以下のボイド数が多く,Al-Fe-Si系粒子 とミクロボイドの粒度分布が近い値を示した。このこ とから,曲げ加工部の外側領域(引張変形領域)におけ るミクロボイドの形成は,Al-Fe-Si系粒子の粒度分布 が影響を及ぼしていると推測される。

Fig.6にFig.3中の局所くびれ領域の反射電子像を示 す。ミクロボイドの両端もしくは片側の端部にAl-Fe-Si系粒子が存在している様子が多く観察された。以上 のことから、曲げ加工度の増加に伴い。①Al-Fe-Si系 粒子が割れ、その隙間にミクロボイドが形成された、 もしくは②Al-Fe-Si系粒子と母相の界面が剥離し、剥 離面でミクロボイドが形成されたと考えられる。ここ で、複数のCT断層像を用いてAl-Fe-Si系粒子とミクロ ボイドの形成状態を確認したが、両端にAl-Fe-Si系粒 子が存在するミクロボイドが多く見られたこと、ミク ロボイドの形成を伴わない粗大な Al-Fe-Si系粒子も存 在することから、①の機構が優位であると考えられる。 このほか、③元々材料中に存在したミクロボイドが曲 げ加工度の増加に伴って大きくなる, ④Mg₂Siまたは シリコン粒子に関連してミクロボイドが形成されるケ ースも考えられる。これらの点を確認するためには, アルミニウムとX線吸収係数の差が小さいMg₂Siおよ びシリコンに関して回折を利用したトモグラフィー⁹⁾ を行うなど、より精度の高い測定を行うことが必要で あり, 今後の課題としたい。

Fig. 7に局所くびれ領域のEBSD解析結果を示す。 方位差15°以上の大角領域を黒線で示し、CI値(同定さ れた方位の信頼値,最大値は1)0.1以下の領域は黒点で 表示した。理想方位から20°以内のCube方位粒はグレ ーで表示した。CI値が0.1以下となるケースは,歪が局 在化している,測定点に疵や異物,第2相粒子が存在 していると考えられるが,矢印部のように帯状かつ断



Fig. 6 SEM image of the localized necking area.

続的に存在している場合, 歪が局在化している部分, すなわち, せん断帯が形成されている部分と考えられ る。Fig. 3およびFig. 6に見られるようにせん断帯上で ミクロボイドが顕著に形成されていることから, せん 断帯上ではAl-Fe-Si系粒子の内部応力が上昇しやすく, 粒子の割れに伴うミクロボイドの形成が顕著であった



Fig. 7 Crystal orientation map at the localized necking area.Black lines are large angle grain boundaries >15°. Black area is the area of CI value < 0.1.</p>





Fig. 8 Scatter diagram of Al-Fe-Si particles.(a) X area in Fig. 4. (b) Y area in Fig. 4.

と考えられる。このように粒子の割れに伴ってミクロ ボイドが形成されるのであれば、粒子のサイズだけで なく形状によっても、ミクロボイドの形成され易さが 変化すると考えられる。

Fig. 8にAl-Fe-Si系粒子のサイズとアスペクト比と 粒径(円相当直径)の関係を示す。Fig. 4中X領域の Al-Fe-Si系粒子は曲げ加工度の増加に伴う割れがほと んど起こっていない。この部分では、円相当直径が 3 µm以下かつアスペクト比3以下の粒子が66%存在す るが、円相当直径が3 µm以上かつアスペクト比3以上 の粒子も4%存在する。一方、外側表層部(Fig. 4中Y 領域)では、円相当直径が3 µm以上かつアスペクト比 3以上の粒子の割合のみが大幅に減少している。この ことから、曲げ加工に伴う粒子の割れは粒子サイズが 大きいだけではなく、アスペクト比が高いほど起こり やすいと考えられる。

3.2 曲げ割れ初期の亀裂発生およびその伝播

局所的なくびれ (localized necking), 板厚内部まで 伝播した割れ (fracture), 微小な割れ (crack) が発生し た各部位における SEM 観察結果を基に割れの発生およ び伝播におけるミクロボイドの役割については以下の 様に考えられる。

Fig. 6に示した局所くびれ領域のSEM観察結果において,局所くびれ領域の最表層近くで微小なミクロボ イドが形成され,外表面に露出しているが,割れは内 部まで伝播しなかった。

Fig. 9に板厚内部まで割れが伝播した領域のSEM観

察結果を示す。最表層において、局所くびれが発生し た痕跡および粗大なミクロボイドが形成されていた痕 跡が観察された。Fig. 10に板厚内部まで割れが伝播し た領域の破面観察結果を示す。ミクロボイドの痕跡と 思われる粒子状の空洞部とその下にせん断破面が観察 された。せん断帯上に形成されたミクロボイドとせん 断帯に沿って割れが伝播したと考えられる。Fig. 10の 一部でディンプル状の破面(延性破面)が観察されるが、 せん断帯の形成されていない結晶粒が周囲の亀裂伝播 応力より引きちぎられて形成されたと考えられる。以 上のことから、板厚内部まで割れが伝播した領域では、 局所くびれが発生した箇所の最表層近くで粗大なミク ロボイドが形成され、これが外表面に露出することで 割れの発生起点になった。さらに、この起点から割れ がせん断帯上に形成されたミクロボイドに沿って板厚



Fig. 9 SEM image of the fracture area.



Fig. 10 Fracture surface morphology at the fracture area.

内部に伝播したと考えられる。

Fig. 11に微小割れ領域のSEM観察結果を示す。微 小割れ領域では,最表層近くの粗大なミクロボイドが 外表面に露出し,微小割れが形成されていた。この部 分では,局所くびれがほとんど発生しておらず,せん 断帯の形成およびせん断帯上でのミクロボイドの形成 も顕著ではなかった。そのため、ミクロボイドとせん 断帯に沿った割れが伝播し難く,板厚内部へ割れが伝 播しなかったと考えられる。この領域において,せん 断帯の形成が顕著でなかった理由については以下のよ うに考えられる。

浅野⁵⁾らおよび竹田ら⁶⁾は曲げ加工性に及ぼす結晶方 位の影響は大きく,特にCube方位は曲げ加工時にせん 断帯が形成され難く,曲げ割れが発生し難い結晶方位



Fig. 11 SEM image of the crack area.



Fig. 12 Crystal orientation map at the crack area. Black lines are large angle grain boundaries $>15^{\circ}$. Black area is the area of CI value < 0.1.



- (a) Before cracking.
- (b) After cracking.

であることを報告している。Fig. 11と同一視野にて EBSD解析を行った結果, Fig. 12に示すように, 微小 割れ領域の直下ではCube方位粒が存在していた。以上 のことから, この領域では, せん断帯の形成が軽微で あり, 割れが伝播し難かったと考えられる。

3.3 曲げ割れ発生メカニズム

メカニズムの模式図をFig. 13に示す。3.1, 3.2で示 した結果より,曲げ割れ発生メカニズムは以下のよう に考えられる。

曲げ加工度の増加に伴い,

- ①変形量の大きい表層近傍でせん断帯が形成(最表面には局所的なくびれが生じる, Fig. 13(a))
- ②表層近傍で粗大な第2相粒子が割れ、ミクロボイドが形成(せん断帯上でより顕著に形成、Fig. 13
 (a))
- さらに曲げ加工度が増加すると,
- ③最表層近くのミクロボイドが外表面に露出し、割れの起点(crack)になる(Fig. 13(b))
- ④ミクロボイドの露出部に歪が局在化し、せん断帯
 上に形成されたミクロボイドに沿って割れ (crack)
 が伝播(Fig. 13 (b))
- ※ただし、割れの起点が形成された近傍にCube方位 粒が存在した場合、せん断帯が形成され難いため 割れが伝播し難い

Fig. 13に示した模式図は平面図 (2D) として簡略化 したものであり,実際の現象 (3D) とは厳密には異なる と思われる。特に,割れの発生と伝播に対しては,断 面図の奥行き方向の平均情報が重要である。例えば割 れの起点と伝播について,最表層近くの外表面に露出 したミクロボイドの分布状態と各方位の結晶粒の分布 状態により,歪の局在化の程度が変化し,どの位置か ら割れが伝播するかどうかが決まると考えられる。

本研究ではFig. 3に示したCT測定部全体の断層像を 確認し,概ね上記のメカニズムに沿うことを確認して いるが,客観的にメカニズムの裏づけをとるためには, 曲げ加工の前,中,後において,同一視野のCT測定 を行い,ミクロボイドとAl-Fe-Si系粒子の分布状態の 変化を観察する必要があり,今後の課題としたい。

4. 結 言

樹脂埋め・研磨された曲げ試験片断面の観察では正確に把握できなかった曲げ割れに及ぼすミクロボイドの影響について、SPring-8を用いたX線CT観察と試料調整方法を改善したSEM観察により、以下のことが明らかになった。

- (1) ミクロボイドの形成 表層近傍のAl-Fe-Si系粒子が割れた隙間および 周りにおいて、ミクロボイドが顕著に形成され た。せん断帯上でより顕著にミクロボイドが形 成された。
- (2)曲げ割れ初期の亀裂発生およびその伝播 曲げ加工度の増加に伴って最表層近くに存在す るミクロボイドが外表面に露出し、割れの起点 になる。この部分に歪が局在化し、せん断帯上 のミクロボイドに沿って割れが伝播する。ただ し、ミクロボイドの露出部(割れの起点)の近傍 にCube方位粒が存在する場合、せん断帯が形成 され難いため、割れが伝播し難くなる。

謝 辞

本研究の一部は、(財)科学技術交流財団主催の研究 会「X線トモグラフィーを利用した構造材料の信頼性向 上」の調査・研究活動に関わるものであり、関係各位に 御礼申し上げます。

また,SPring-8 を用いたシンクロトロン放射光実験 (研究成果番号:2011B1111)を行った公益財団法人高 輝度光科学研究センターに心より感謝します。

参考文献

- 浅野峰生, 箕田 正, 吉田英雄: 軽金属学会第106回春期大会 概要集, (2004), 5-6.
- 2) 浅野峰生,内田秀俊,吉田英雄:軽金属,52(2002),448-452.
- 3) 浅野峰生, 箕田 正, 他2名: 軽金属, 56 (2006), 371-375.
- 日比野 旭, 村松俊樹, 佐賀 誠, 高田 健: 軽金属, 53 (2003), 534-541.
- 5) 浅野峰生, 伊川慎吾, 他2名: 軽金属学会第111回秋期大会概 要集, (2006), 243-244.
- 6) 竹田博貴, 日比野 旭, 高田 健: 軽金属, 60 (2010), 231-236.
- 7) 戸田裕之,小林正和,鈴木芳生,竹内晃久,上杉健太朗:顕微 鏡,44 (2009),199-205.
- H. Toda, K. Minami, K. Koyama, K. Ichitani, M. Kobayashi, K. Uesugi and Y.Suzuki : Acta Mater., 57 (2009), 4391-4403.
- L. Qian, H. Toda, K. Uesugi, M. Kobayashi and T. Kobayashi : Physical Review Letters, 100, No.11 (2008), 115505.



山本 裕介 (Yusuke Yamamoto) (株)UACJ 技術開発研究所 名古屋センター 第三部



浅野 峰生 (Mineo Asano)(株) UACJ 技術開発研究所 名古屋センター 第三部



吉田 英雄 (Hideo Yoshida)(株) UACJ 技術開発研究所



小林 正和 (Masakazu Kobayashi) 豊橋技術科学大学機械工学系



戸田 裕之 (Hiroyuki Toda) 九州大学工学研究院機械工学部門